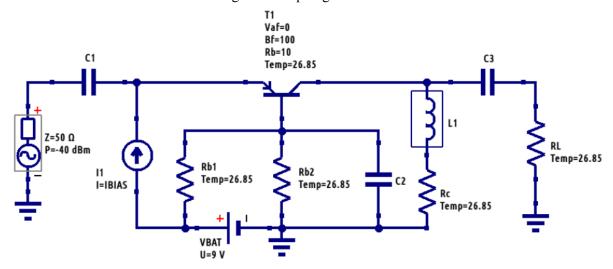
# UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC CENTRO TECNOLÓGICO - CTC DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA CURSO DE ENGENHARIA ELETRÔNICA EEL 7319 - CIRCUITOS RF

PATRIK LOFF PERES 20103830

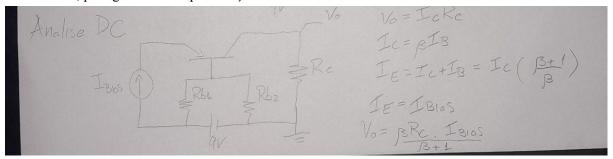
Relatório 4 - Amplificador de Baixo Ruído

Será projetado um amplificador de baixo ruído, conforme o circuito da figura 1

Figura 1 - Topologia



As especificações deste amplificador são: Rin =  $50\Omega$  e ganho de tensão Av = 50dB = 316. Inicialmente, para garantir as especificações será feita a análise DC do circuito.

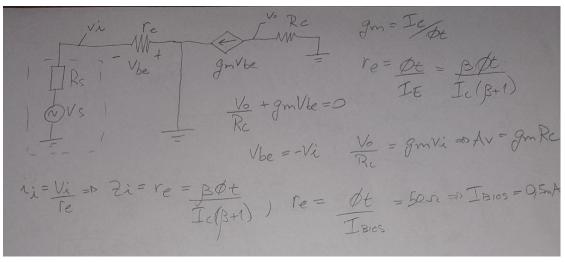


Para fins de análise, foi considerado operações em baixas frequências, de forma que podemos desconsiderar a capacitância parasita do transistor, além de considerar capacitores e indutores ideais com capacidade e indutância infinitas.

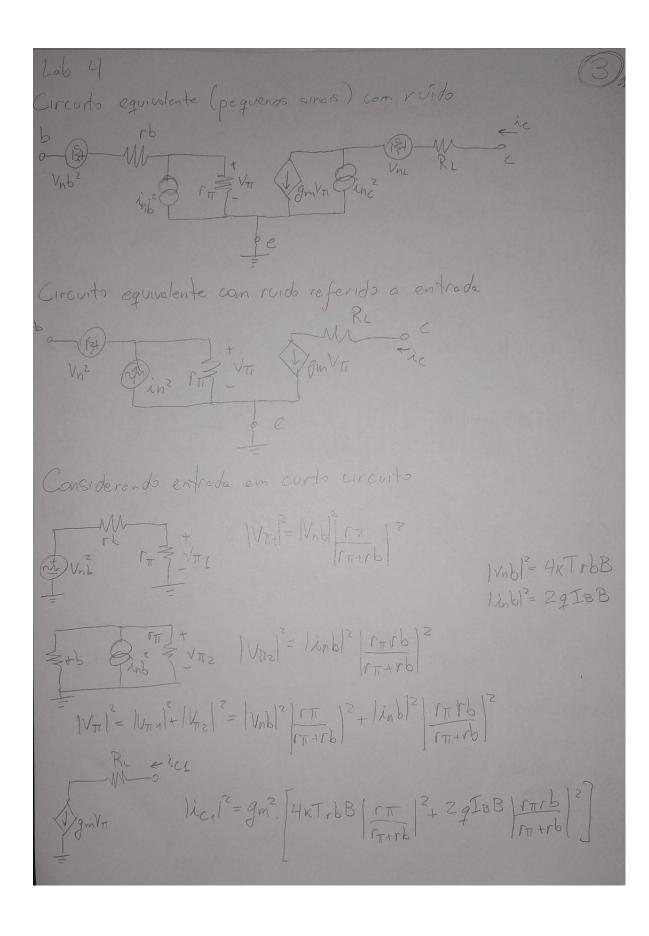
Tal simplificação é tomada por que os capacitores e indutores, neste circuito, estão sendo usados para isolar o circuito de polarização do circuito de sinal.

Nota-se por inspeção no circuito que os resistores da base estão operando como divisor de tensão da bateria, para garantir nível de tensão DC na base do transistor, também o resistor Rc define (juntamente com Ibias que será mencionada em breve) a tensão de coletor, que tem que ser tal que Vce<Vsat para garantir que o transistor irá funcionar na região ativa.

Realizando a análise AC do circuito,



Para garantir os parâmetros de projeto, podemos definir  $I_{bias}=0$ , 5mA e  $R_L=16350\Omega$  Sendo assim, podemos definir de forma arbitrária os resistores da base e o resistor do coletor Rc, para garantir os níveis de tensão mencionados,  $R_{b1}=R_{b2}=1k\Omega$  e  $R_c=10k\Omega$ . Definido o circuito do amplificador, vamos calcular NF,  $NF_{min}$  e  $R_{sopt}$ .



122 = 12nc = 29ICB icl= |icl+ |icl+ |ics+ |ics+ |ics+ = 4xTrbB | gmrT|2+2qI8B | gmrTrb | + 2qI6B licl=4KTrbB gmrnP+2qIoB gmrnrbP+2qIoB+4KTRLB - Vn<sup>2</sup> (π = Vπ ) fmVπ te |ic|<sup>2</sup> = gm<sup>2</sup> |Vn|<sup>2</sup> 1/n/2= 4x TrbB | CT |2+ 29 [3B | 17 16 |2 + 29 IC B | 17 1+16 | 2 + 29 IC B Considerando entrado em aberto 10 1 | VII |2 = IT | linb|2

Lab 4

Re ice  $|ic|^2 = g_n^2 r_n^2 |inb|^2$   $|ic|^2 = g_n^2 r_n^2 |inb|^2$   $|ic|^2 = g_n^2 r_n^2 |inb|^2$   $|ic|^2 = g_n^2 r_n^2 2g_1 B_0 + 2g_1 B_0$   $|ic|^2 = g_n^2 r_n^2 2g_1 B_0 + 2g_1 B_0$   $|ic|^2 = g_n^2 r_n^2 2g_1 B_0 + 2g_1 B_0$   $|ic|^2 = g_n^2 r_n^2 2g_1 B_0 + 2g_1 B_0$   $|ic|^2 = g_n^2 r_n^2 2g_1 B_0$   $|ic|^2 = g_n^2 r_n^2 |in|^2$   $|ic|^2 = g_n^2 r_n^2 |in|^2$ 

Resolvendo numericamente NF, Rsopt e NFmin, temos que:

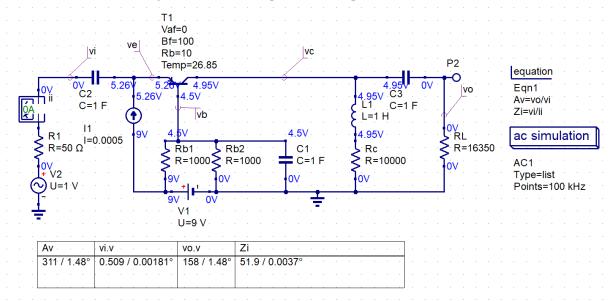
 $NF_{Rs=50} = 1,728964373879718$ 

 $NF_{min} = 1,108334794551803$ 

 $R_{sopt} = 608,9646177570338\Omega$ 

Simulando o circuito no QUCS:

Figura 2 - Simulação polarização e parâmetros



Nota-se que a impedância de entrada foi de aproximadamente  $50\Omega$  e o ganho de tensão de aproximadamente 310, como esperado. Com base na simulação do circuito da figura 2 submetido ao testbench de figura de ruído desenvolvido no lab 2 da figura 3, e na solução numérica das equações de NFmin e Rsopt, podemos exprimir os resultados na figura 4.

Figura 3 - testbench

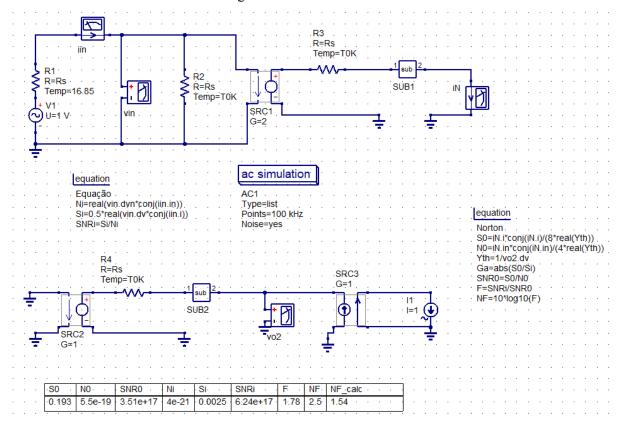
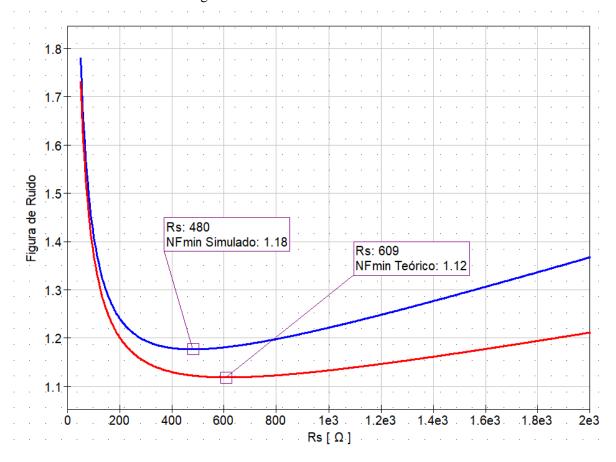


Figura 4 - Gráfico dos resultados



Nota-se que para Rs=50Ω a figura de ruído foi de 1,78, valor próximo ao teórico, porém o resultado simulado divergiu do resultado teórico à medida que Rs aumenta, além de que o ponto de figura de ruído mínimo foi diferente.

Substituindo o transistor ideal do circuito da figura 1 pelo modelo do BC857A e mudando apenas Rc para  $8k\Omega$  para garantir que ele não sature, podemos usar as mesmas equações do caso anterior

$$\begin{split} NF_{Rs=50} &= 1,577630787099623 \\ NF_{min} &= 1,056706701818477 \\ R_{sopt} &= 1007,682109703788 \Omega \end{split}$$

Simulando no QUCS:

Figura 5 - Simulação

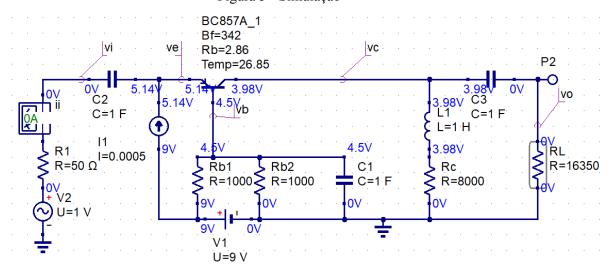
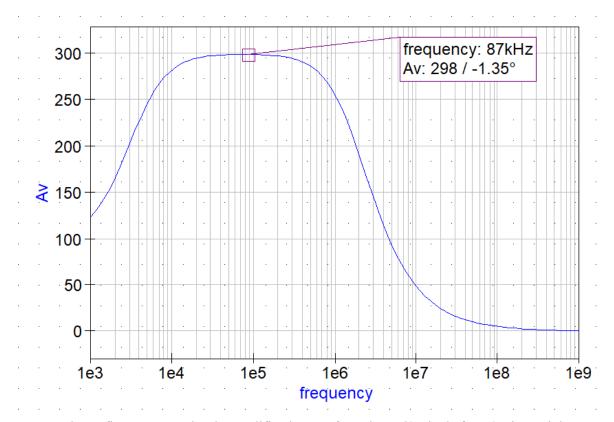


Figura 6 - Ganho



Nota-se do gráfico que o ganho do amplificador tem forte dependência da frequência e sai da zona de operação na faixa dos megahertz, além de que, mesmo na faixa de frequência onde o transistor está na região ativa, o ganho foi menor do que os  $\sim 310$  esperado.

1.6 1.5 Ruido 1.4 Figura de 1.3 Rs: 484 NFmin Simulado: 1.13 1.2 Rs: 1.07e+03 NFmin Teórico: 1.06 200 400 600 800 1.2e3 1e3 1.6e3 1.8e3

Figura 7 - Gráfico dos resultados BC857A

Os resultados da simulação mostra que para  $Rs = 50\Omega$  a figura de ruído teórica e simulada deram resultados próximos, mas como no caso do transistor ideal, a medida que Rs aumenta os resultados começam a divergir, além de que o ponto de NFmin não é o mesmo.

## Questões:

## 1) O que você aprendeu com este experimento?

Como entender melhor como polarizar um transistor, e a ideia de isolar a polarização do circuito em si com o uso de capacitores e indutores que até então passavam batido quando fazia exercícios com elementos não lineares.

Rs [ $\Omega$ ]

Também, solidificar os conhecimentos sobre figura de ruído e principalmente como determiná-la analiticamente pelo método de ruído referido a entrada.

#### 2) Quais foram as suas dificuldades?

Tive que fazer e refazer algumas vezes até encontrar os erros o que demandou muito tempo, os resultados teóricos dificilmente batem com os simulados e eu nao sei se eu errei algo na álgebra ou na análise, ou se é por conta de alguma não idealidade ou premissa como por exemplo assumir que as fonte vn e in são independentes no cálculo da figura de ruído pelo método de ruído referido a entrada.

Além disso, não consegui fazer a parte do amplificador cascode por falta de tempo e principalmente porque não tinha muito claro quais eram os passos para conseguir analisar aquele circuito.

#### 3) O que fez e/ou fará para superá-las?

Estudar mais